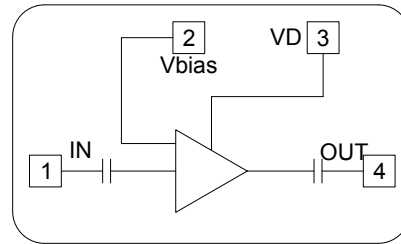


特点：

- 频率：0.9~1.3GHz
- 增益：20.2dB
- 输出-1dB 压缩点：26.4dBm
- 单电源工作：+5V@265mA
- 工作温度：-55~+85℃
- 芯片尺寸：1.1×1.25×0.1mm

功能框图



性能参数：(TA=+25℃, VD=+5V, ID=265mA)

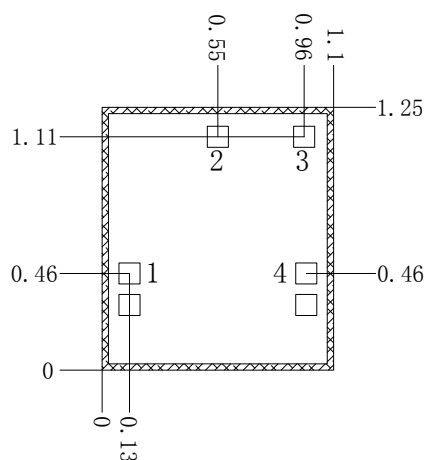
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+5.0V Zin=Zout=50Ω	0.9		1.3	GHz	
增益	G		19	20.2		dB	
增益平坦度	ΔG			0.6	2	dB	
输入驻波	VSWRi			1.8	2		
输出驻波	VSWRo			1.8	2		
噪声系数	NF			3.8	4	dB	
输出 P ₋₁	P ₋₁		25	26.4		dBm	
输出 IP3	OIP3		35	36.5		dBm	
电压	VD		4.75	5	5.25	V	
电流	ID	VD=+5.0V		265	300	mA	

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+6	V	最大输入功率	+18	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

芯片尺寸图：

单位：mm

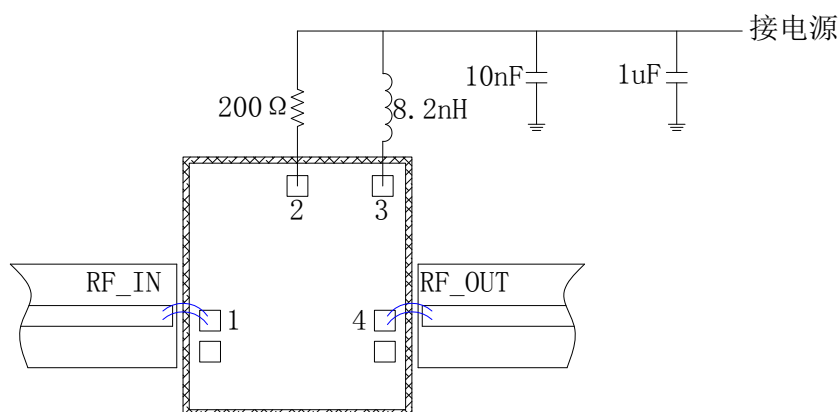


注：典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

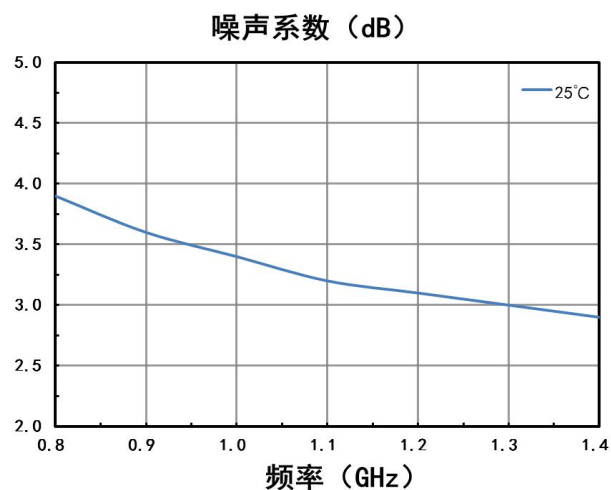
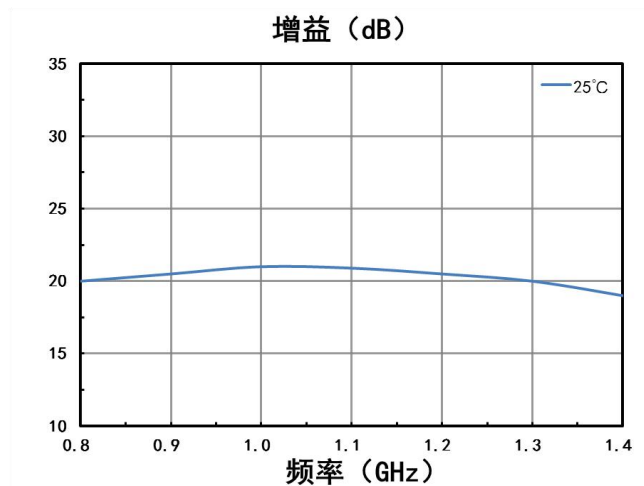
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2, 3	VD	放大器电源电压，需外接 1uF 和 10nF 旁路电容
4	OUT	射频输出，AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：

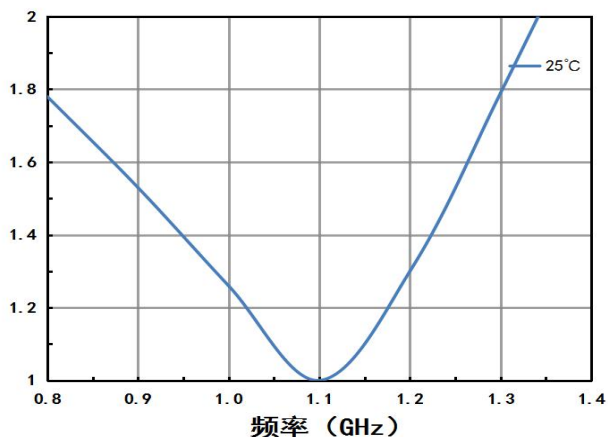


注：未标注的键合焊盘不需要连接

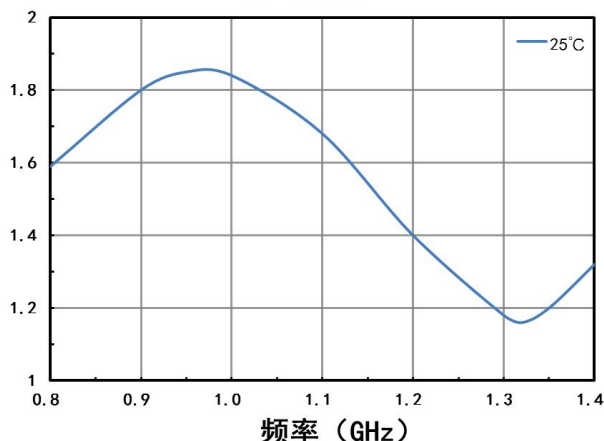
典型测试曲线：



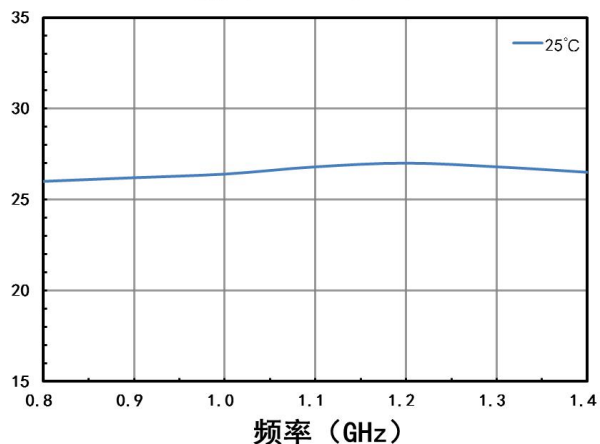
输入驻波比



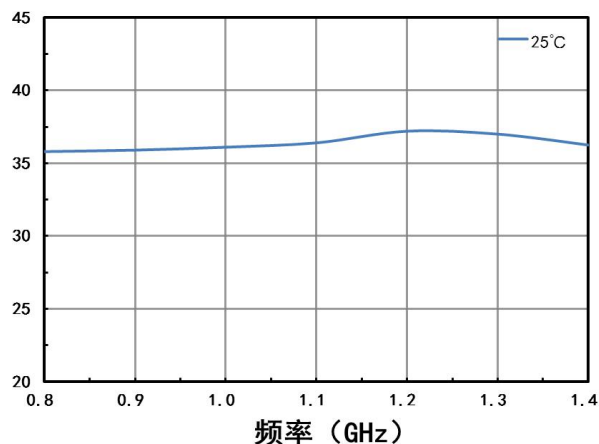
输出驻波比



输出P-1dB (dBm)



输出IP3 (dBm)



产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间断不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。